

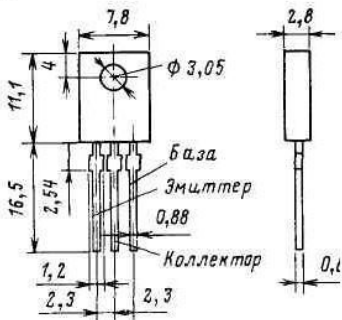
КТ816А, КТ816Б, КТ816В, КТ816Г

Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарные *p-n-p* уни-версальные низкочастотные мощные.

Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях и импульсных схемах

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 0,7 г



Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_3 = 100$ мА, $\tau_n \leq 300$ мкс, $Q \geq 100$ не менее

КТ816А	25 В
КТ816Б	45 В
КТ816В	60 В
КТ816Г	80 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 3$ А, $I_B = 0,3$ А не более

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 3$ А, $I_B = 0,3$ А не более

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 2$ В, $I_K = 2$ А не менее

при $T_k = 298 - 373$ К	25
при $T = 233$ К	15

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 10$ В, $I_K = 0,25$ А не менее

Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, $f = 465$ кГц не более

Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В, $f = 465$ кГц не более

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 25$ В КТ816А,	
при $U_{КБ} = 45$ В КТ817Б, при $U_{КБ} = 60$ В КТ816В,	
при $U_{КБ} = 100$ В КТ816Г не более	
при $T_k = 298$ К	100 мкА
при $T_k = 373$ К	3000 мкА

Предельные эксплуатационные данные

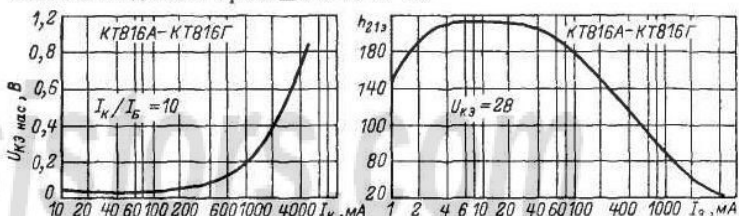
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $I_B = 0$	
КТ816А	25 В
КТ816Б	45 В
КТ816В	60 В
КТ816Г	80 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 1$ кОм	
КТ816А	40 В

КТ816Б	45 В
КТ816В	60 В
КТ816Г	100 В
Постоянное напряжение база-эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора	3 А
Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 20$ мс, $Q \geq 100$	6 А
Постоянный ток базы	1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом при $T_k = 233 - 298$ К	25 Вт
без теплоотвода при $T = 233 - 298$ К	1 Вт
Температура перехода	398 К
Температура окружающей среды	От 233 до $T_k = 373$ К

Примечание Пайку выводов разрешается проводить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. При пайке жало паяльника должно быть заземлено.

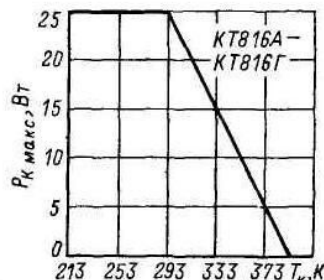
Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5–2 мм, при этом должны приниматься меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

При монтаже транзисторов на теплоотвод крутящий момент при нажиме не должен превышать 70 Н·см.

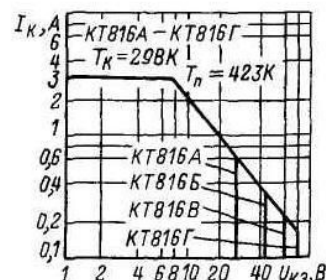


Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора

Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса



Область максимальных режимов